

01:07

## Метод матриц переноса для сред с квадратичной оптической нелинейностью

© С.В. Федоров<sup>1</sup>, М.А. Калитеевский<sup>2</sup>, Н.В. Луковская<sup>2</sup>, В.В. Николаев<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Институт лазерной физики,  
199034 Санкт-Петербург, Россия

<sup>2</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,  
194021 Санкт-Петербург, Россия

(Поступило в Редакцию 2 апреля 1998 г.)

Разработан метод матриц переноса для сред, содержащих нелинейные слои. Данный метод позволяет рассчитывать распространение света, профиль электромагнитного поля, а также генерацию второй гармоники в слоистых структурах, содержащих слой с квадратичной нелинейностью.

Метод матриц переноса [1–5] является широко распространенным методом расчета оптических свойств слоистых структур. В случае слоистой среды задачи о распространении света в слоистой структуре и нахождении частот собственных оптических [1] и поляритонных [3] мод слоистой структуры сводятся к перемножению матриц переноса через отдельные слои, из которых состоит структура. Для линейной среды матрицы переноса имеют размерность  $2 \times 2$ . Конкретный вид матриц определяется выбором пары параметров (базиса), описывающих электромагнитное поле. Наиболее часто в качестве базиса используются тангенциальные по отношению к границе раздела двух сред компоненты электрического и магнитного полей [2] или амплитуды волн, распространяющихся в противоположных направлениях [3].

В случае когда на каком-либо слое имеет место смешение различных волн (например, на решетке квантовых проводов, где смешиваются падающая и дифрагированная волны), матрица переноса имеет размерность, равную удвоенному числу смешивающихся волн [4].

Последние достижения в области вертикальных лазеров, в частности экспериментально обнаруженная в таком приборе генерация второй гармоники [6,7], требуют создания адекватной расчетно-теоретической методики, позволяющей эффективно решать задачи о распространении света в слоистых структурах, содержащих нелинейные слои.

Целью данной работы является разработка метода матриц переноса для сред с квадратичной нелинейностью.

Рассмотрим слоистую структуру, на которую падает волна частоты  $\omega$  с амплитудой  $\tilde{E}_1$ . Пусть в состав структуры входят слои, в которых осуществляется удвоение частоты света. Амплитудные коэффициенты отражения и пропускания света на частотах  $\omega$  и  $2\omega$   $r_1$ ,  $r_2$  и  $t_1$ ,  $t_2$  могут быть найдены как решение системы линейных уравнений

$$\begin{pmatrix} t_1 \tilde{E}_1 \\ 0 \\ t_2 \tilde{E}_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \hat{T} \begin{pmatrix} \tilde{E}_1 \\ r_1 \tilde{E}_1 \\ 0 \\ r_2 \tilde{E}_1 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Здесь матрица переноса через структуру  $\hat{T}$  представляет собой произведение матриц переноса через отдельные слои и границы между ними. Матрица переноса через один нелинейный слой определяется путем решения системы дифференциальных уравнений типа [7]

$$\frac{dE_{\pm 1}}{dz} = \pm ik_1 E_{\pm 1} - i\eta E_{\pm 1}^* E_{\pm 2}, \quad (2a)$$

$$\frac{dE_{\pm 2}}{dz} = \pm ik_2 E_{\pm 2} - i\eta E_{\pm 1}^2, \quad (2b)$$

где  $E_{\pm 1,2}$  — амплитуды волн, распространяющихся по нормали к слоям (направлению оси  $z$ ) и в противоположном направлении соответственно;  $\eta(\omega) = (\omega^2/2c^2)\varepsilon_{i,kl}(\omega)e_i e_k e_l$  — параметр нелинейности, пропорциональный сумме компонент тензора нелинейной восприимчивости второго порядка  $\varepsilon_{ikl}(\omega, 2\omega)$ .

Если нелинейность мала настолько, что мало меняет амплитуду за один проход нелинейного слоя, то решение системы (2) записывается в виде

$$E_{\pm 1}(z) = \exp(\pm ik_1 z)(A_{\pm 1} E_{\pm 10} - i\eta z E_{\pm 10}^* E_{\pm 20}), \quad (3a)$$

$$E_{\pm 2}(z) = \exp(\pm ik_2 z)(A_{\pm 2} E_{\pm 20} - i\eta z E_{\pm 10}^2), \quad (3b)$$

где  $E_{\pm 10}$  и  $E_{\pm 20}$  — амплитуды волн на границе нелинейного слоя и  $A_{\pm 1} = 1$  при  $|\eta z E_{\pm 10}| \ll 1$ .

Матрица переноса через нелинейный слой толщины  $d_j$  в этом приближении будет иметь недиагональный вид

$$\hat{N}_j = \begin{pmatrix} A_{+1} e^{ik_1 d_j} & 0 & -i\eta d_j E_{+10}^* e^{ik_1 d_j} & 0 \\ 0 & A_{-1} e^{-ik_1 d_j} & 0 & -i\eta d_j E_{-10}^* e^{-ik_1 d_j} \\ -i\eta d_j E_{+10} e^{ik_2 d_j} & 0 & A_{+2} e^{ik_2 d_j} & 0 \\ 0 & -i\eta d_j E_{-10} e^{-ik_2 d_j} & 0 & A_{-2} e^{-ik_2 d_j} \end{pmatrix}. \quad (4)$$

В случае произвольной величины нелинейности на одном проходе отдельного слоя точное решение системы (2) с учетом двух интегралов уравнений сводится к

эллиптическому интегралу [8]. Такое решение можно представить формулами (3), считая, что величины  $A_{\pm 1,2}$  зависят от координаты и входных амплитуд  $A_{\pm 1,2}(z, E_{\pm 10}, E_{\pm 20})$ . При этом структура матрицы переноса (5) не меняется, поскольку нелинейное взаимодействие волн происходит попарно.

Для нахождения матрицы переноса через нелинейный слой (4), а значит и матрицы переноса всей системы  $\hat{T}$ , необходимо задать амплитуды волн с частотами  $\omega$  и  $2\omega$  на границе нелинейного слоя  $E_{\pm 10}$  и  $E_{\pm 20}$  через амплитуду падающего излучения  $\tilde{E}_1$ , однако сделать это можно только зная амплитуду отраженных от системы волн  $r_{1,2}\tilde{E}_1$ , поскольку

$$\begin{pmatrix} E_{+10} \\ E_{-10} \\ E_{+20} \\ E_{-20} \end{pmatrix} = \hat{L} \begin{pmatrix} \tilde{E}_1 \\ r_1\tilde{E}_1 \\ 0 \\ r_2\tilde{E}_1 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

где  $\hat{L}$  — матрица переноса от края структуры до границы нелинейного слоя.

В то же время коэффициенты отражения  $r_{1,2}$  определяются из решения (1), для чего надо знать матрицу переноса всей системы  $\hat{T}$ .

Для разрешения этой коллизии воспользуемся теорией возмущенных по малому параметру нелинейности  $\eta$ . В нулевом приближении (т.е. для линейной теории) матрица переноса в нелинейном слое вырождается в диагональную матрицу, а матрица всей системы  $\hat{T}^{(0)}$  и коэффициенты отражения  $r_{1,2}^{(0)}$  и пропускания  $t_{1,2}^{(0)}$  не зависят от величины амплитуд  $E_{\pm 10}$  и  $E_{\pm 20}$ .

Определив в  $n$ -м порядке теории возмущений вид матрицы всей системы  $\hat{T}^{(n)}$ , мы определим значения  $r_{1,2}^{(n)}, t_{1,2}^{(n)}$  с помощью (1). После этого нужно определить величину амплитуд  $E_{\pm 10}^{(n+1)}$  и  $E_{\pm 20}^{(n+1)}$  следующим образом:

$$\begin{pmatrix} E_{+10}^{(n+1)} \\ E_{-10}^{(n+1)} \\ E_{+20}^{(n+1)} \\ E_{-20}^{(n+1)} \end{pmatrix} = \hat{L} \begin{pmatrix} \tilde{E}_1 \\ r_1^{(n)}\tilde{E}_1 \\ 0 \\ r_2^{(n)}\tilde{E}_1 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Подставляя (6) в (4), мы определим вид матриц нелинейных слоев  $\tilde{N}_j^{(n+1)}$ , а значит и матрицы всей системы  $\hat{T}^{(n+1)}$  в  $n+1$ -м порядке теории возмущений. Сходимость итерационного процесса при  $n \rightarrow \infty$  гарантируется [8] для  $\eta D|\tilde{E}_1| < 1$ , где  $D$  — полная толщина структуры. В результате мы разрешаем систему алгебраических уравнений типа (1) относительно неизвестных амплитуд поля в нелинейных слоях.

В заключение отметим универсальность предложенного алгоритма матриц переноса и спектральных параметров нелинейных слоистых систем. Он легко обобщается на случай как больших размерностей матриц, когда поле излучения описывается большим числом попарно смешивающихся плоских волн, так и на другой тип нелинейности слоев.

Авторы выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований (грант № 97-02-18341).

## Список литературы

- [1] *Калитеевский М.А., Кавокин А.В.* // ФТТ. 1995. Т. 37. Вып. 10. С. 2721–2728.
- [2] *Борн М., Вольф Э.* Основы оптики. М.: Наука, 1970. С. 77.
- [3] *Kavokin A.V., Kaliteevski M.A.* // Sol. St. Commun. 1995. Vol. 95. N 12. P. 859–862.
- [4] *Kavokin A.V., Kaliteevski M.A., Vladimirova M.R.* // Phys. Rev. B. 1996. Vol. 54. N 3. P. 1490–1493.
- [5] *Ivchenko E.L., Kaliteevski M.A., Kavokin A.V., Nesvizhskii A.I.* // J. Opt. Soc. Amer. B. 1996. Vol. 13. N 5. P. 1061–1069.
- [6] *Yamada N., Kaneka Y., Nakagama S.* et al. // Appl. Phys. Lett. 1996. Vol. 68. N 14. P. 1895–1897.
- [7] *Rosencher E., Vinter B., Berger V.* // J. Appl. Phys. 1995. Vol. 78. N 10. P. 6042–6045.
- [8] *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982. С. 524–530.